

1. はじめに

放射光実験施設(PF)では、これまで、2.5GeV のストレージリングからシンクロトロン放射光を 発生させるのに電子ビームを蓄積してきたが、昨 年の7月中旬より、電子ビームの代りに陽電子 ビームをPFリングに蓄積し、その放射光を利用 する運転を開始した¹⁾。陽電子ビームを使う目的 は、電子ビームの場合にストレージリングに見ら れるイオン捕獲や微粒子捕獲等によるビームの寿 命の急変などの不安定性を取り除き、より安定し た放射光をユーザに供給することにある。今期の 夏の運転終了時点で、陽電子のテスト入射より、 ほぼ1年経過したことになる。これを期に、PF リングへの陽電子の生成と入射及び蓄積の経緯と 現状について報告する。

PFリングに陽電子を蓄積するためには、まず リニアックから2.5GeVの陽電子ビームを供給す ることが必要である。陽電子ビームは、トリスタ ンの実験用に数年前から既に実用化されてはいた が、電子と陽電子の衝突実験に使用するために、 パルス幅が2nsと極端に短い。このためビーム の電荷量は15ns程度で、従来使用してきた電子 ビームの約1/300であり、かなり少ない。その ため、この陽電子ビームを従来の電子用の入 射システムにより入射したのでは入射に20時間以 上かかり実用的ではない。そこで,光源,入射器 共同のプロジェクトチームをつくり,30分以下で 300mAまで蓄積することを目標に,電荷量の多 い陽電子ビームの開発及び必要な装置の製作と改 良を進めてきた。その結果,パルス幅が~40ns で電荷量が~70nsのセミ長パルスビームが開発 され,リングでも従来の1Hzの入射システムが 25Hzのものに置き換えられることにより,約30 分~1時間程度の入射で300mAの陽電子が,リ ングに蓄積されるようになった^{2),3)}。

最近では、トリガー系等の改良により実際に ビームを入射している時間がかなり短縮され、最 後の1ヵ月半程の運転では10分程度で終了すると ころまで改善された。又、そもそもの目的であっ たイオン捕獲や微粒子捕獲によるビームの不安定 性が取り除かれたことも確認された。問題点はま だ多数残っているが、解決すべく鋭意努力中である。

2. 加速器の概略構成

関係する加速器の構成を図1に示す。放射光実 験施設は、2.5GeVの電子リニアックと蓄積リン グより成っているが、リングについては他に解説 があるのでここでは省き、リニアックの概説のみ 述べる。PF リングにビームを供給する入射器は, 図1に示すように、2種類の加速器によって構成 されている。第一は,長さが約400mの2.5GeV 電子リニアックである。これは、2.5GeVの電子 ビームを供給するためのものであり、現在は主に トリスタンの蓄積加速リングに2nsのビームを 供給するのに使用している。PFでも、リングの 真空の焼きだし等には現在でも、電子ビーム(~ 0.7μs)を使用することがある。第二の加速器は, 陽電子ビームを生成するための陽電子発生装置の リニアックである。このリニアックは、大電流の 電子ビームを250MeV まで加速する部分と、そ のビームをタンタルの標的に当てて生成した陽電 子を250MeV まで加速する部分とから成る。こ



Fig. 1 Schematic arrangement of accelerators in KEK.

 Table. 1
 Available electron and positron beams for the PF ring and the accumlator ring of TRISTAN

	PF	AR
e+	40ns, (2ns)	2 ns
e-	\sim 0.7 μ s, 2 ns	2 ns

こで生成された250 MeV の陽電子ビームは,30 度偏向電磁石系をへて,2.5 GeV のリニアックに 輸送,入射され,更に加速されて最終的には2.5 GeVになる。この陽電子ビームは,PFリングのほ かにトリスタンの蓄積加速リング(AR)にも供 給されている。

このように, PF リニアックから, PF リング とAR の相方に複数の種類のビームを供給してい る。供給可能なビームの種類を、**Table** 1 に示 す。PF リングに入射する陽電子ビームは,通常 40ns のビームである。PF リング用の 2 ns の陽 電子ビームは,遠隔操作によるビームの切り換え がまだできないので,括弧付きにした。このビー ムは,マシンスタディ等の特別な場合にのみ利用 可能である。このビームを除けば,ビームの種類 は,主制御室から遠隔操作によって短時間で切り 換えることができる。

リニアックで加速されたビームは、図1のよう にビーム輸送路により約150m 程輸送されてPF リングに蓄積される。



Fig. 2 The RF power observed at the exit of an accelerator section in the electron-accelerating part.

3. 電子ビームの発生と加速

まず,陽電子を生成するのに使用する電子ビー ムについて説明する。この電子ビームは,陽電子 発生装置の最も上流にある電子銃から供給される。 この電子銃は,グリッド付の三極管型である。

電子銃から放出されたビームは、直線上に設置 された6本の加速管によって加速される。各加速 管はマイクロ波によって満たされており、電子が 加速管を通過するときに、このマイクロ波のパ ワーを一部分吸収する。吸収されるパワーは、加 速管を通過したビームの電荷量に比例する。した がって、短パルスビームが加速管内を通過すると、 加速管内のパワーが、時間とともに減少する。電 子ビームの場合には電荷量が大きいので、この変 化が激しい。このため、パルスビームの先頭にあ る電子は強い電場で加速され、後部にある電子は 弱い電場によって加速されることになる。従って、 電子ビームのエネルギーがパルス内で変化する。 このために生ずるエネルギー幅が大きくなると, ビームを集束することが困難になり、ビームサイ ズが大きくなってしまって輸送できなくなる。こ の現象によって、加速できるビームの電荷量(パ ルスあたり)には限界が生じる。

ここで、加速マイクロ波のパワーの減少する様 子を、図2に示す。これは最初の加速管の出力パ ワーをモニターしたもので、以下に述べる40ns、 3 Aのパルスビームを加速した場合である。 3 μ sec 加速マイクロ波のパワーが、電子ビームの



Fig. 3 Mechanism of the positron production.

負荷によって、40nsの間に大きく減少している。 これからも判るように、40nsのビームの場合に は、加速できる電子ビームの電荷量が既に限界に 近いところまで来ている。尚、減少している時間 が0.4*µ*secであるのは、加速管の特性による。

4. 陽電子ビームの生成

次に、陽電子ビームの生成について解説する。 最初に,陽電子の生成そのものについて簡単に説 明することにする。図3に、陽電子の生成機構を 概念的に図示した。まず, 高エネルギーの電子ビー ムを標的(金属板)に照射すると、電子が標的の 原子核の近くを通過するときに強力な電場の引力 を受けて電子の軌道が曲げられ、制動輻射のガン マー線が発生する。このガンマー線が標的中を通 過する間に,他の原子核の電磁場と相互作用して, 電子と陽電子を対生成する。ガンマー線のエネル ギーが十分に高い場合は、対生成された電子と陽 電子のペアのエネルギーが高くなり、標的の反対 側から飛び出してくる。この陽電子はいろいろな 方向に出てくるので、強力なソレノイド磁場で集 束させた後、必要なエネルギーまで加速する。電 子の方は減速されて低エネルギーになり、途中で 失われてしまう。このようにして陽電子ビームが 得られる。

4.1 電荷量の多い陽電子ビームの発生

さて次に、電荷量の多い陽電子ビームを、どの ようにして開発したかについて述べる。対生成の 数は、電子ビームのエネルギーと電荷量の積にほ ぼ比例する。従って、電荷量の多い陽電子ビームを 得ようとすれば、1次粒子である電子ビームのエ ネルギーと電荷量を大きくすることが必要になる。 ビームのエネルギーは、加速マイクロ波のパワー の平行根にほぼ比例してしか増大しないので、エ ネルギーを増大させる方法を取る場合には、マイ クロ波のパワーを大幅に増強することが必要にな る。しかし、これには大幅な改造が必要で、容易 なことではない。そこで、電子ビームの電荷量を 増やす方法をとることにした。

陽電子発生装置の場合は、最終的に得られる陽 電子の数は、1次ビームである電子の0.1%程度 である。この割合は極めて小さいので、電子ビー ムは大電流でなければならない。既に実用化して いる2nsのビームの電流を大幅に増やせれば、 問題はないのであるが、それには大規模な改造を 要する。幸いにして, PFリングで必要とするビー ムは、トリスタンと異なり2ns である必要はな いので、パルス幅を長くして電荷量を増やすこと ができる。ただし,陽電子発生装置では,設計上, マイクロ秒の長パルスビームは加速することがで きない。そこで、40ns のパルス幅のビームを開 発した。この結果,陽電子ビームの種類が2ns と40ns の2 種類になったので、ビームの切り換 えが新たに必要になる(ともに営業運転であるの で、遠隔操作で瞬時に切り換えなければならな い)。これらのために、新しく必要になった装置 の主なものは、次の4点である。

(1) 40nsのビーム用グリッドパルサー。

これは、電子銃のグリッドとカソード間に印加 する40nsのパルスを発生するパルサーである。

(2) 2 ns と40ns のビームのいずれか一方を選 択するための、長/短パルス切換装置。

2種類あるグリッドパルサーの一方を同軸切換 器で選択するものである。グリッドパルサーと同 軸切換器は電子銃の高電圧部にあるので,光信号 で切換器を動作させている。

(3) PFリング用陽電子ビームのトリガー系。トリスタンとPFでは、リングの加速周波数が

異なるために,独立なトリガー系を必要とする。 これもビームの種類によって切り換える。

(4) ビーム輸送系の電磁石の電流値を設定する ための制御系。

2 ns と40ns のビームでは電子ビームの電流が 大きく異なるため,電磁石の電流値を変えないと ビームをうまく輸送することができない。そこで, ビームに応じて輸送系の電流値を,この制御系で 所定の値に設定する。

(2)と(3)の選択は,主制御室の制御卓にある押し ボタンで行い,(4)の設定は同じ制御卓のタッチパ ネルを介して計算機で行う。これらの一連の作業 により,トリスタンの入射モードからPFの入射 モードへ,あるいはその逆の変更が数分で終了す る。

4.2 陽電子のビーム電流の推移

さて、陽電子の電流値がリニアックで過去一年 間にどのように推移したかを、図4に示す。横軸 は通算の日数で、陽電子ビームのテスト入射が始 まった昨年の7月11日から数えた。データのない ところは、保守期間である。測定箇所は、30度偏 向系から2.5GeVラインに入り加速管3本を通過 した所(WM16,~300MeV)と、2.5GeVリニ アックの終端(WM 58,2.5GeV)の2ヵ所であ る。約300MeVの所では、ビーム電流は比較的安 定しており、電子銃のアノード電流に比例して次



Fig. 4 The progress of the 40 nsec positron beam for the PF ring. Until July 30 of last year, the 2 nsec beam was used, till then 40 nsec beam.



Fig. 5 The outline of the beam transport line.

第に増加している。しかし,2.5GeV リニアック の終端では,ビーム電流の変動がやや大きくなっ ている。これは,陽電子ビームがエミッタンスの 大きな二次ビームであるために,必然的にビーム サイズが大きくなり(加速管の内径程度),長い 距離加速するのが難しくなっていることの現れで ある。

5.PFリングへの陽電子ビームの輸送

次にリニアックにより加速された2.5GeV の陽 電子ビームのPF リングへの輸送について解説す る。

5.1 ビーム輸送路

2.5GeV に加速された陽電子ビームは, ライ ナック終端からビーム輸送路により約150m程輸 送されて, PFリングの入射点に到達する。ビー ム輸送路の概略を図5に示す。陽電子ビームは, ライナック終端より約20mのスイッチングヤー ド直線部を経て水平偏向電磁石により5度偏向さ れて輸送路へと導かれる。輸送路では, 先ず水平 方向に2回15度偏向され, 次にPFリングのレベ ルにビームの高さを合わせるため, 垂直方向に 7.5度はね上げられた後, 水平レベルにもどされ, 最後に水平面内で15度偏向されてPFリング入射 点に達する。輸送路のエネルギーアクセプタンス は0.5%である。この輸送路にはビームをハンド リングするため,全部で12台のスクリーンモニ ターと7台のコア付カレントモニター,及び2台 の壁電流モニターが設置されている。また,この ビーム輸送路では、中ほどにある分散の大きいセ クションでビームのエネルギースペクトルを測定 することができるようになっている。

5.2 ライナック終端と輸送路入口の電子光学 系の整合について

先に述べたように, 陽電子の加速は二段階にわ たって行われる。すなわち、陽電子ライナックで 発生した250MeVの陽電子ビームを2.5GeVメイ ンライナックに入射し, ビームを2.5GeV まで加 速する。この際、陽電子ビームの電流値が最大に なるように調整するために、電子光学系の四極電 磁石を調整する。このため2.5GeVライナックの 終端で電子光学系のパラメータが調整に伴って変 化し、その後につながるビーム輸送路の光学系と の間に不整合を生ずる。このため、ライナック終 端と、ビーム輸送路入口の間の約20mの直線部 にある5台の四極電磁石をマッチングセクション として使用し(図5)、両者の整合をとった。整 合をとる手順は次の3ステップにより行った。 i) ライナック終端での電子光学系のパラメー タを測定する。



- Fig. 6 Beam size measurements in beam transport line with screen monitor; (A)before adjustment, (B)after adjustment.
- ii) i)で測定したパラメータから、マッチン グセクションの四極電磁石の電流値を計算する。
- ii) ii)で得られた電流値をセットし、ビームの輸送状態から整合がとれたかどうか観測し、
 整合が不十分であれば、i)にもどって繰り返し整合をとりなおす。

通常,2回程度整合を取りなおすと十分である。 図6にマッチングをとる前と後でのビームサイズ の変化を輸送路のスクリーンモニターにより測定 した結果を示す。整合をとる前で,ビームは輸送 路に入って程なくした所(PM9の付近)で発散 し,ビームサイズの測定が不可能となった。この 時のビームの輸送効率は10%以下であった。マッ チングをとった後は、この発散はなくなり輸送効 率も60~80%程度に上昇した。

上記の整合をとる際にi)で電子光学系のパラ メータを測定するが、この際に、ビームエミッタ ンスも同時に観測される。その結果、陽電子ビー ムのエミッタンスは2.5GeVライナック終端で約 1.0*10⁻⁶mradで、電子ビームのエミッタンス は約0.3*10⁻⁶mrad、比較して、約3倍程度大きい。 この原因は2次粒子であるポジトロンビームが、 加速管のアクセプタンスいっぱいに広がって来る ためと思われる。

6. PFリングへの陽電子ビームの入射

最初に、ストレージリングの入射について、簡 単な解説をする。図7に示すような平衡軌道を持 つリングへの入射を考える。リングは適当な偏向 電磁石と四極電磁石から成るものとし、入射点の ところに、リングにほぼ平行にビームを打ち込ん だとする。入射されたビームは図7-Aのように 四極電磁石のオフセンターを通過し、その焦点距 離に応じて次々に進路を曲げられ、大きく振動し ながらリングの中を回り始める。そしてビームは リング内を数回転したところで、入射した位置に もどって来る。ところが、入射点には、ビームを リングとほぼ平行に曲げるためのセプタム電磁石 (特殊なパルス偏向電磁石)があるので,このま まではビームはセプタムに当って失われてしまう。 そこで、図7-Bに示すように、入射点で軌道を パルス的にふくらませて (パルスバンプ) やると, 入射ビームの振幅がその分小さくなるので、数 ターン後にビームが元の位置にもどって来るまで にこのパルスバンプをひっこめてやると、ビーム はセプタムには衝突せずにリング内を回転しつづ けることができる。そこで、リングにRF 加速空 洞があれば加速フィールドにつかまってリングに 蓄積される。

以下にPF リングへの陽電子の入射について述 べる。

- 0 :QUADRUPOLE MAGNET
- ∆ :BENDING MAGNET



(B) with pulse-bump



6.1 陽電子用の入射システム

PF リングの入射点付近のパルス電磁石の配置 を図8に示す。リングとビーム輸送路との間の角 度は12度であるので,二台のセプタム電磁石によ りそれぞれ7度と5度ビームを偏向し,リングの 平衡軌道に対して34mm, - 2 mrad ずれた所に



Fig. 8 The arrangement of the septum and kicker magnets.





Fig. 9 Injected beam phase space ;(A)horizontal, (B)vertical.

ビームを入射する。リング側では四台のキッカー 電磁石(パルス偏向電磁石)によりパルスバンプ を形成する。パルスバンプの大きさ及び角度は21 mm,-1 mradに設定してある。

6.2 陽電子の**PF**リングへの入射

これらの入射システムのもとで入射されたビー ムがどのようにリングの中を回転し始めるか位相 空間で計算した結果を図9-A,Bに示す。PF リングでは、横方向にパルスバンプがなければ、 ほぼ4ターン目で元の位置にもどって来るが、パ ルスバンプのおかげで、ビームは4ターン目まで に平衡軌道の周りに移動し、回転し続けることが できる。入射ビームは横方向にも、縦方向にも放

射減衰して小さくなるまで、大きなエミッタンス で回転するのでリングのアクセプタンスが十分で ないと入射できない。特に、縦方向には陽電子ビー ムのエミッタンスは電子の約3倍ほどあるので大 きなアクセプタンスが必要である。PFリングは もともと陽電子を蓄積するように設計されたリン グではないので,特に縦方向にアクセプタンスが 十分にあるかどうか調べなければならない(PF リングにはアンジュレーターのダクトなどのよう な縦に極めて狭いダクトが何ヶ所も入っている)。 そこで、アクセプタンスの大きさを調べるために 入射されたビームが実際にリング内を周回してい くときに、ビーム電流の減衰する様子を電流モニ ターにより測定した。結果を図10に示す。この図 で時間方向に並んだ1本1本が, ビームが電流モ ニターを通過するごとに観測された電流ピークに



Fig.10 An observed current decay of the injected beam.

対応する。これらのピークの時間方向の減衰が, ビーム電流のリング内での減衰を示すが,最初の 5~6ターンで約60%に減衰する(パルスバンプ がかかっているとき)以外には,急激な減衰は見 られず,リングのアクセプタンスは一応十分と思 われる。最初の数ターンで見られる~40%の損失 は,パルスバンプのエラーなどによると思われ, 今後の改善課題である。こうして入射されたビー ムにRF加速をかければ,リングに蓄積される。 最近測定された陽電子ビームのリングへの蓄積パ ターンを図11に示す。このときのリニアックから のビームは,上に述べた40nsec 幅のビームを使 用し,入射の繰り返しは25Hzで行った。最近で は,平均的に0.3~0.4mA/sec の蓄積率(1秒 間に蓄積される電流値)を得ている。

7. 蓄積率の最近の推移

上述のような経緯で、PFリングへの陽電子ビームの蓄積が進められたが、蓄積率を見ると1988年7月に運転を始めた当初は~0.05であったものが現在では約10倍の0.58mA/secを記録するまでに至った。これまでの蓄積率の推移を図12に示す。この図を見ると、蓄積率は時間とともにほぼ線形



Fig.11 A typical accumulation pattern of the positron beam.



Fig.12 The progress of the accumulation rate in the PF ring.

上昇していることが見られる。今年の5月14日か ら6月6日までの運転では,蓄積率が小さくなっ ているが,これはリニアックでRFに対するビー ムのタイミングが適切でなかったためで,このタ イミングを合わせた結果,蓄積率が3月の状態 (~0.3mA/s)に戻った。さらに,その後,リ ングとリニアックとの間の同期をとるためのトリ ガー信号が3割程減少していることが判明し,こ れを改善したところ,蓄積率がさらに増加して, 上述の0.58mA/sを記録した。現在、実際の入 射では,ビームシャッターを閉じてからユーザー に引き渡されるまでに約2時間を要しているが, このうち実際にビームを入射しているのは10分以 下である。

今後,1989年の秋からは,新ウィグラーがリン グに挿入され,横方向のアクセプタンスが小さく なるので蓄積率が多少下がる可能性があるが,そ の分ウィグラーの上下動に要する時間がなくなる のでユーザータイムはふえる方向に行くと思われ る。また,近い将来に陽電子ビームの繰り返しが 25Hz から50Hz になれば,あと2倍程度は蓄積 率があがると思われる。

8. 最後に

陽電子ビームの発生とPFリングへの蓄積の経 過と現状について述べてきたが、初期の目標で あった30分以内でリングにビームを蓄積すること を達成し、又、1989年1月23日には500mAの陽 電子をリングに蓄積することに成功した(この電 流値は現在のところワールドレコードである)。 最後になったが特に中心になってこのプロジェ クトを進めてきたグループのメンバーを紹介して 本稿をとじることにする。以下敬称略 浅見 明,穴見 昌三,阿部 勇,浦野 隆夫, 榎本 収志,大沢 哲,小川 雄二郎,桂 共太 郎,加藤 政博,小林 正典,小林 仁,斉藤 芳男,佐藤 佳博,三橋 利行,山川 達也,横 田 光弘。

参考文献

- 1) K.Fuke:Rev.Sci.Instrum., 1382, 60(7), July (1989).
- 2) S.Ohsawa et al. : "Positron beams for PF Storage Ring", Proc. of the XIV Int.Conf. on High Energy Accel., to be published.
- 3) T.Mitsuhashi et al.; "Accumulation of Positrons into the Photon Factory Storage Ring", Proc. of the XIV Int. Conf. on High Energy Accel., to be published.